









	<h2 style="color: #E67E22;">FDB088N08_F141</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB088N08_F141
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 75V 120A D2PAK
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB088N08_F141
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 75V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6595pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 120A (Tc) 160W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB088N08_F141 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB088N08_F141-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB088N08_F141 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB088N08_F141 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB088N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>	 <p>FDB082N15ATM FAIRCHILD FDB082N15ATM FAIRCHILD</p>	 <p>FDB10AN06AO FAI FDB10AN06AO FAI</p>	 <p>FDB10N20C VB FDB10N20C VB</p>
 <p>FDB088N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 75A D2PAK</p>	 <p>FDB10AN06AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-263AB</p>	 <p>FDB110N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 92A D2PAK</p>	 <p>FDB10AN06AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB088N08_F141 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB088N08_F141 Datenblatt	FDB088N08_F141-Datenblätter	FDB088N08_F141 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB088N08_F141
FDB088N08_F141 Electronic	FDB088N08_F141-Komponenten	FDB088N08_F141-Verteiler	FDB088N08_F141-Bild	FDB088N08_F141-Teil
FDB088N08_F141 Preis	FDB088N08_F141 Hersteller	FDB088N08_F141 Bild	FDB088N08_F141 Aktie	FDB088N08_F141 Inventar
FDB088N08_F141 Neu	FDB088N08_F141 Original	FDB088N08_F141 garantiert	FDB088N08_F141 RFQ	FDB088N08_F141 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited